Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanejl

X-mas tree



Ciało stałe 3

Wydział Fizyki UW Jacek.Szczytko@fuw.edu.pl Piotr.Fita@fuw.edu.pl

1100-3003







Nasz cel:

Twierdzenie Blocha

$$\varphi_{n,\vec{k}}(\vec{r}) = u_{n,\vec{k}}(\vec{r}) e^{i\vec{k}\vec{r}}$$





pasm do pierwszej strefy

19.12.2019

Twierdzenie Blocha

Przybliżenia:

Rdzenie nieruchome, ustawione w sieć przestrzenną. Przybliżenie jednoelektronowe (przybliżenie Hartree'ego)

 $\Psi_{el}^k(\vec{r}_1,\vec{r}_2,\vec{r}_3,\dots) = \varphi_1(\vec{r}_1) \cdot \varphi_2(\vec{r}_2) \cdot \varphi_3(\vec{r}_3) \cdot \dots \cdot \varphi_n(\vec{r}_n)$

lub przybliżenie Hartree-Focka (wyznacznik Slatera).

Metoda pola samouzgodnionego - sprowadzamy zagadnienie wieloelektronowe do rozważania jednego elektronu znajdującego się w potencjale pochodzącym od jonów w węzłach i pozostałych elektronów.



$$\left(\frac{p^2}{2m} + V(\vec{r})\right)\varphi_n(\vec{r}_n) = E_n\varphi_n(\vec{r}_n)$$

"Jednoelektronowe" równanie Schrödingera

Potencjał efektywny, periodyczny z okresem sieci, jednakowy dla wszystkich elektronów.

$$V(\vec{r}) = V\left(\vec{r} + \vec{R}\right)$$

Twierdzenie Blocha

Jeśli potencjał jest periodyczny $V(\vec{r}) = V(\vec{r} + \vec{R})$ to rozwiązania równania Schrödingera

$$\left(\frac{p^2}{2m} + V(\vec{r})\right)\varphi_{n,\vec{k}}(\vec{r}) = E_{n,\vec{k}}\varphi_{n,\vec{k}}(\vec{r})$$

mają postać:

$$\varphi_{n,\vec{k}}(\vec{r}) = u_{n,\vec{k}}(\vec{r}) e^{i\vec{k}\vec{r}}$$

fala płaska

funkcja Blocha, stan Blocha

gdzie tzw. f. Blocha:

$$\begin{split} u_{n,\vec{k}}(\vec{r}) &= u_{n,\vec{k}} \big(\vec{r} + \vec{R} \big) \\ \varphi_{n,\vec{k}}(\vec{r}) &= \varphi_{n,\vec{k}+\vec{G}}(\vec{r}) \end{split}$$



Wektory sieci Bravais



"You want proof? I'll give you proof!"

Twierdzenie Blocha

$$arphi_{n,ec{k}}(ec{r}) = u_{n,ec{k}}(ec{r}) \, e^{iec{k}ec{r}}$$
nkcja Blocha,
n Blocha

Pokazaliśmy, że rozwiązanie jednoelektronowego równania Schrödingera w potencjale periodycznym ma postać modulowanej fali płaskiej o periodzie sieci:

$$u_{n,\vec{k}}(\vec{r}) = u_{n,\vec{k}}(\vec{r} + \vec{R})$$



Wprowadziliśmy oznaczenie *n* dla różnych rozwiązań odpowiadających temu samemu \vec{k} (*indeks* pasm). Wektor \vec{k} należy wtedy do *pierwszej strefy Brillouina*.

$$u_{n,\vec{k}}(\vec{r}) = \sum_{\vec{G}} C_{\vec{k}-\vec{G}} e^{i\vec{G}\vec{r}}$$

fur

sta

Twierdzenie Blocha

Właściwości funkcji Blocha: $\varphi_{n,\vec{k}}(\vec{r}) = u_{n,\vec{k}}(\vec{r}) e^{i\vec{k}\vec{r}}$

- 1. $u_{n,\vec{k}}(\vec{r}+\vec{R}) = u_{n,\vec{k}}(\vec{r})$
- 2. $\varphi_{n,\vec{k}+\vec{G}}(\vec{r}) = \varphi_{n,\vec{k}}(\vec{r})$
- $3. \quad E_n(\vec{k}) = E_n(\vec{k} + \vec{G})$
- 4. Inwersja w przestrzeni $E_n(\vec{k}) = E_n(-\vec{k})$
- 5. Inwersja w czasie (bez pola magnetycznego)

 $E_n(\vec{k},\uparrow) = E_n(-\vec{k},\downarrow)$



W przypadku funkcji Blocha
$$\varphi_{\vec{k}}(\vec{r}) = u_{\vec{k}}(\vec{r})e^{i\vec{k}\vec{r}}$$
:
 $\varphi_{\vec{k}}(\vec{r}+N_j\vec{a}_j) = u_{\vec{k}}(\vec{r}+N_j\vec{a}_j)e^{i\vec{k}(\vec{r}+N_j\vec{a}_j)}$
 $= u_{\vec{k}}(\vec{r})e^{i\vec{k}\vec{r}}e^{i\vec{k}N_j\vec{a}_j}$

Musimy zażądać, żeby $e^{i\vec{k}N_j\vec{a}_j} = 1$

$$\vec{k}_j = 0, \pm \frac{2\pi}{L_j}, \pm \frac{4\pi}{L_j}, \dots, \pm \frac{2\pi N_j}{L_j}$$



dozwolone wektory falowe stanowią dyskretną sieć punktów równomiernie rozłożoną w przestrzeni wektora falowego; komórkę elementarną sieci odwrotnej (strefę Brillouina) wypełnia

$$N_1 \cdot N_2 \cdot N_3$$

takich punktów. Tyle też będzie stanów w każdym paśmie. N_1 , N_2 , N_3 mogą być różne, ale najczęściej przyjmujemy takie same

M. Baj Fizyka materii skondensowanej i struktur półprzewodnikowych

Gęstość stanów

Gęstość stanów Ilość stanów na jednostkę energii $\rho^{nD}(E)$ (zależy od ilości wymiarów)

Jeśli nasz kryształ ma skończone rozmiary zbiór wektorów k jest skończony (choć olbrzymi!), np. możemy przyjąć periodyczne warunki brzegowe i wtedy:



Density of states

Gęstość stanów Ilość stanów na jednostkę energii $\rho^{nD}(E)$ (zależy od ilości wymiarów)

Jeśli nasz kryształ ma skończone rozmiary zbiór wektorów k jest skończony (choć olbrzymi!), np. możemy przyjąć periodyczne warunki brzegowe i wtedy:



Twierdzenie Blocha

Funkcje Blocha, których wektory falowe różnią się o wektor sieci odwrotnej są IDENTYCZNE!

 $\psi_{n,\vec{k}+\vec{G}}(\vec{r}) = \psi_{n,\vec{k}}(\vec{r})$



 $\vec{k}_1 - \vec{k}_2 = \vec{G}$

Twierdzenie Blocha

Funkcje Blocha, których wektory falowe różnią się o wektor przestrzeni odwrotnej \vec{G} są takie same! $\psi_{n,\vec{k}+\vec{G}}(\vec{r}) = \psi_{n,\vec{k}}(\vec{r})$ $\vec{G} = h\vec{g}_1 + k\vec{g}_2 + l\vec{g}_3$

Co z energią?

$$\begin{pmatrix} \frac{\vec{p}^2}{2m_0} + V(\vec{r}) \end{pmatrix} \psi_{n,\vec{k}}(\vec{r}) = E(n,\vec{k}) \ \psi_{n,\vec{k}}(\vec{r})$$
$$\begin{pmatrix} \frac{\vec{p}^2}{2m_0} + V(\vec{r}) \end{pmatrix} \psi_{n,\vec{k}+\vec{G}}(\vec{r}) = E(n,\vec{k}+\vec{G}) \ \psi_{n,\vec{k}+\vec{G}}(\vec{r})$$

Energia jest periodyczną funkcją wektora falowego \vec{k} !

 $\Rightarrow E(n,\vec{k}) = E(n,\vec{k}+\vec{G})$

Model prawie swobodnych elektronów

Wartości własne energii są periodyczną funkcją liczby kwantowej k.

 $E_n(\vec{k}) = E_n(\vec{k} + \vec{G})$

Model prawie swobodnych elektronów – dla fali płaskiej w pustej przestrzeni energia od wektora falowego wyraża się wzorem:

$$E_{n=1}\left(\vec{k}\right) = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$$



Model prawie swobodnych elektronów

Wartości własne energii są periodyczną funkcją liczby kwantowej k.

 $E_n(\vec{k}) = E_n(\vec{k} + \vec{G})$

Model prawie swobodnych elektronów – dla fali płaskiej w pustej przestrzeni energia od wektora falowego wyraża się wzorem: $k^2 l_{L}^2$

$$E_{n=1}(\vec{k}) = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} = E_n(\vec{k} + \vec{G}) = \frac{\hbar^2 (\vec{k} + \vec{G})^2}{2m}$$



Model prawie swobodnych elektronów

Wartości własne energii są periodyczną funkcją liczby kwantowej k.

 $E_n(\vec{k}) = E_n(\vec{k} + \vec{G})$

Model prawie swobodnych elektronów – dla fali płaskiej w pustej przestrzeni energia od wektora falowego wyraża się wzorem: $\hbar^2 L^2$

$$E_{n=1}(\vec{k}) = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} = E_n(\vec{k} + \vec{G}) = \frac{\hbar^2 (\vec{k} + \vec{G})^2}{2m}$$



Model prawie swobodnych elektronów

Wartości własne energii są periodyczną funkcją liczby kwantowej k.

 $E_n(\vec{k}) = E_n(\vec{k} + \vec{G})$

Model prawie swobodnych elektronów – dla fali płaskiej w pustej przestrzeni energia od wektora falowego wyraża się wzorem: $\hbar^2 l_z^2$

$$E_{n=1}(\vec{k}) = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} = E_n(\vec{k} + \vec{G}) = \frac{\hbar^2 (\vec{k} + \vec{G})^2}{2m}$$



Model prawie swobodnych elektronów

Wartości własne energii są periodyczną funkcją liczby kwantowej k.

 $E_n(\vec{k}) = E_n(\vec{k} + \vec{G})$

Model prawie swobodnych elektronów – dla fali płaskiej w pustej przestrzeni energia od wektora falowego wyraża się wzorem: $\hbar^2 L^2$

$$E_{n=1}(\vec{k}) = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} = E_n(\vec{k} + \vec{G}) = \frac{\hbar^2 (\vec{k} + \vec{G})^2}{2m}$$



Model prawie swobodnych elektronów

Wartości własne energii są periodyczną funkcją liczby kwantowej k.

 $E_n(\vec{k}) = E_n(\vec{k} + \vec{G})$

Model prawie swobodnych elektronów – dla fali płaskiej w pustej przestrzeni energia od wektora falowego wyraża się wzorem: $\hbar^2 l_{12}^2$





Podstawy modelu jednoelektronowego



Podstawy modelu jednoelektronowego



Podstawy modelu jednoelektronowego



Strefy Brillouina

$$\vec{R} = n_1 \vec{a}_1 + n_2 \vec{a}_2 + n_3 \vec{a}_3, \qquad n_i \in \mathbb{Z} \vec{G} = m_1 \vec{a}_1^* + m_2 \vec{a}_2^* + m_3 \vec{a}_3^*, \qquad m_i \in \mathbb{Z}$$



Strefa Brillouina w przestrzeni 2-wymiarowej, sieć ukośnokątna.





Strefa Brillouina dla sieci kubicznej powierzchniowo centrowanej (fcc). Ograniczające strefę ściany kwadratowe i sześciokątne pochodzą, odpowiednio, od punktów sieci odwrotnej typu (2,0,0) i (1,1,1).

http://oen.dydaktyka.agh.edu.pl/dydaktyka/fizyka/c_teoria_pasmowa/2.php

Strefy Brillouina

$$\vec{R} = n_1 \vec{a}_1 + n_2 \vec{a}_2 + n_3 \vec{a}_3, \qquad n_i \vec{G} = m_1 \vec{a}_1^* + m_2 \vec{a}_2^* + m_3 \vec{a}_3^*, \qquad m_i$$

 $\vec{a}_i^* \vec{a}_j = 2\pi \delta_{ij}$

$$n_i \in \mathbb{Z}$$

 $m_i \in \mathbb{Z}$

Konstrukcja stref Brillouina w dwuwymiarowej, kwadratowej sieci odwrotnej



Strefy Brillouina

$$\vec{R} = n_1 \vec{a}_1 + n_2 \vec{a}_2 + n_3 \vec{a}_3, \qquad n_i \in \mathbb{Z} \vec{G} = m_1 \vec{a}_1^* + m_2 \vec{a}_2^* + m_3 \vec{a}_3^*, \qquad m_i \in \mathbb{Z}$$

 $\vec{a}_i^* \vec{a}_j = 2\pi \delta_{ij}$

 $\in \mathbb{Z}$







Strefy Brillouina

$$\vec{R} = n_1 \vec{a}_1 + n_2 \vec{a}_2 + n_3 \vec{a}_3, \qquad n_i \in \mathbb{Z} \vec{G} = m_1 \vec{a}_1^* + m_2 \vec{a}_2^* + m_3 \vec{a}_3^*, \qquad m_i \in \mathbb{Z}$$





Strefy Brillouina

$$\vec{R} = n_1 \vec{a}_1 + n_2 \vec{a}_2 + n_3 \vec{a}_3, \qquad n_i \in \mathbb{Z} \vec{G} = m_1 \vec{a}_1^* + m_2 \vec{a}_2^* + m_3 \vec{a}_3^*, \qquad m_i \in \mathbb{Z}$$



Strefy Brillouina

$$\vec{R} = n_1 \vec{a}_1 + n_2 \vec{a}_2 + n_3 \vec{a}_3, \qquad n_i \in \mathbb{Z}$$

$$\vec{G} = m_1 \vec{a}_1^* + m_2 \vec{a}_2^* + m_3 \vec{a}_3^*, \qquad m_i \in \mathbb{Z}$$







Ibach, Luth



Yu, Cardona Fundametals of semiconductors

Fig. 2.2. (a) The crystal structure of diamond and zinc-blende (ZnS). (b) the fcc lattice showing a set of primitive lattice vectors. (c) The reciprocal lattice of the fcc lattice shown with the first Brillouin zone. Special high-symmetry points are denoted by Γ , X, and L, while high-symmetry lines joining some of these points are labeled as Λ and Δ

19.12.2019

Metoda ciasnego wiązania - wnioski



Fig. 7.11. (a) Theoretical bandstructure $E(\mathbf{k})$ for Al along directions of high symmetry (Γ is the center of the Brillouin zone). The dotted lines are the energy bands that one would obtain if the *s*- and *p*-electrons in Al were completely free ("empty" lattice). After [7.3]. (b) Cross section through the Brillouin zone of Al. The zone edges are indicated by the dashed lines. The Fermi "sphere" of Al (——) extends beyond the edges of the first Brillouin zone





Fig. V.3. Illustration of the photoemission process. (a) A photon of energy $h\nu$ excites an electron from the initial state $E^{(i)}(k)$ to the final state $E^{(i)}(k)$ above the vacuum level E_{vac} . The kinetic energy of the photoemitted electron is $E_{\text{kin}} = E^{(i)}(k) - E_{\text{vac}}$. (b) The wave vectors of the electron inside $k^{(\text{int})}$ and outside $k^{(\text{ext})}$ have the same parallel components since the spatial phase $ir_{\parallel}k_{\parallel}$ has to be identical to make the wave function continuous at any given point r_{\parallel} of the surface

Rys. V.2. Pomiar rozkładu kątowego widma fotoelektronów z powierzchni miedzi. Widmo (a) zarejestrowano z powierzchni Cu(111) w kierunku [111]. Widma (b) i (c) pochodzą z powierzchni Cu(110) i rejestrowane były pod kątami biegunowymi odpowiednio 35,2° i 52,5°. Wielkość wektora k stanu początkowego odpowiadającego widmu (a) wyznaczona jest przez rzut wektora k, dla którego takie samo widmo rejestrowane jest z powierzchni (110) (wg [V.2])



Struktura pasmowa ciał stałych



http://www.physics.berkeley.edu/research/lanzara/research/Graphite.html

Struktura pasmowa ciał stałych



Równanie kp – masa efektywna



Landolt-Boernstein

Poziomy energetyczne



Teoria pasmowa ciał stałych.


Teoria pasmowa ciał stałych.



37

Struktura pasmowa ciał stałych

Make things as simple as possible, but not simpler.



$$\varphi_{n,\vec{k}}(\vec{r}) = e^{i\vec{k}\vec{r}}u_{n,\vec{k}}(\vec{r})$$

Wektor \vec{k} nie jest pędem (operator pędu $\hat{p} = -i\hbar\nabla$)

$$\hat{p}\varphi_{n,\vec{k}}(\vec{r}) = -i\hbar\left(u_{n,\vec{k}}\ i\vec{k} + \nabla u_{n,\vec{k}}(\vec{r})\right)e^{i\vec{k}\vec{r}} \neq \hbar\vec{k}\varphi_{n,\vec{k}}(\vec{r})$$

Funkcja Blocha w równaniu Schrödingera:

$$\Delta \varphi_{n,\vec{k}}(\vec{r}) = \dots = \left(\Delta u_{n,\vec{k}}(\vec{r}) + 2i\vec{k}\nabla u_{n,\vec{k}}(\vec{r}) - \vec{k}^2 u_{n,\vec{k}}(\vec{r})\right)e^{i\vec{k}\vec{r}}$$

Po wstawieniu do równania i uproszczeniu przez $e^{i\vec{k}\vec{r}}$ dostajemy równanie na $u_{n\vec{k}}(\vec{r})$:

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\,\Delta - \frac{\hbar}{m}\,i\vec{k}\nabla + \frac{\hbar^2}{2m}\vec{k}^2\right)u_{n,\vec{k}}(\vec{r}) = \left(\frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{\hbar}{m}\,\vec{k}\hat{p} + \frac{\hbar^2\vec{k}^2}{2m}\right)u_{n,\vec{k}}(\vec{r})$$

Równanie Schrodingera na obwiednię $u_{n,\vec{k}}(\vec{r})$:

$$\left(\frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{\hbar}{m}\vec{k}\hat{p} + V(\vec{r})\right)u_{n,\vec{k}}(\vec{r}) = \left(E_n - \frac{\hbar^2\vec{k}^2}{2m}\right)u_{n,\vec{k}}(\vec{r})$$

$$\varphi_{n,\vec{k}}(\vec{r}) = e^{i\vec{k}\vec{r}}u_{n,\vec{k}}(\vec{r})$$

Wektor \vec{k} nie jest pędem (operator pędu $\hat{p} = -i\hbar\nabla$)

$$\hat{p}\varphi_{n,\vec{k}}(\vec{r}) = -i\hbar\left(u_{n,\vec{k}}\ i\vec{k} + \nabla u_{n,\vec{k}}(\vec{r})\right)e^{i\vec{k}\vec{r}} \neq \hbar\vec{k}\varphi_{n,\vec{k}}(\vec{r})$$

Funkcja Blocha w równaniu Schrödingera:

$$\Delta \varphi_{n,\vec{k}}(\vec{r}) = \dots = \left(\Delta u_{n,\vec{k}}(\vec{r}) + 2i\vec{k}\nabla u_{n,\vec{k}}(\vec{r}) - \vec{k}^2 u_{n,\vec{k}}(\vec{r})\right)e^{i\vec{k}\vec{r}}$$

Po wstawieniu do równania i uproszczeniu przez $e^{i\vec{k}\vec{r}}$ dostajemy równanie na $u_{n\vec{k}}(\vec{r})$:

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\,\Delta - \frac{\hbar}{m}\,i\vec{k}\nabla + \frac{\hbar^2}{2m}\vec{k}^2\right)u_{n,\vec{k}}(\vec{r}) = \left(\frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{\hbar}{m}\vec{k}\hat{p} + \frac{\hbar^2\vec{k}^2}{2m}\right)u_{n,\vec{k}}(\vec{r})$$

Równanie Schrodingera na obwiednię $u_{n,\vec{k}}(\vec{r})$:

$$\left(\frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{\hbar}{m} \vec{k}\hat{p} + V(\vec{r})\right)u_{n,\vec{k}}(\vec{r}) = \left(E_n - \frac{\hbar^2\vec{k}^2}{2m}\right)u_{n,\vec{k}}(\vec{r})$$

Równanie Schrodingera na obwiednię $u_{n,\vec{k}}(\vec{r})$:

$$\left(\frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{\hbar}{m}\,\vec{k}\hat{p} + V(\vec{r})\right)u_{n,\vec{k}}(\vec{r}) = \left(E - \frac{\hbar^2\vec{k}^2}{2m}\right)u_{n,\vec{k}}(\vec{r})$$

Jest to tzw. równanie kp wykorzystywane do obliczeń energii i funkcji falowych wokół pewnego znanego rozwiązania dla $\vec{k} = \vec{k}_0$.

Pełny hamiltonian

$$\widehat{H}_{\vec{k}}u_{n,\vec{k}}(\vec{r}) = \left(\widehat{H}_{\vec{k}_0} + \widehat{H}'\right)u_{n,\vec{k}}(\vec{r}) = E_n(\vec{k})u_{n,\vec{k}}(\vec{r})$$

Zaburzenie:

$$\widehat{H}' = \frac{\hbar}{m} \left(\vec{k} - \vec{k}_0 \right) \hat{p}$$

Funkcję $u_{n,\vec{k}}(\vec{r})$ oraz energię $E_n(\vec{k})$ znajdujemy w rachunku zaburzeń

Rozwijamy
$$E_n(\vec{k}) = \left(E_n - \frac{\hbar^2 \vec{k}^2}{2m}\right)$$
 wokół punktu ekstremalnego, np. $k = 0$:
 $E_n(\vec{k}) = E_n(0) + H'_{nn} + \sum_{l \neq n} \frac{|H'_{nl}|^2}{E_n(0) - E_l(0)} + \cdots$

Dla

$$H'_{nl} = \int u_{n,0}(\vec{r}) \hat{H}' \, u_{l,0}(\vec{r}) \, d^3r = -\frac{i\hbar}{m} \vec{k} \int u_{n,0}(\vec{r}) \nabla u_{l,0}(\vec{r}) \, d^3r = \sum_{i=1}^3 a_i k_i$$

Liniowe w \vec{k}

$$E_{n}(\vec{k}) = E_{n}(0) + \sum_{i=1}^{3} a_{i}k_{i} + \sum_{i=1}^{3} \sum_{j=1}^{3} \left(\frac{\hbar^{2}}{2m} \,\delta_{ij} + b_{ij}\right) k_{i}k_{j} + \cdots$$

W ekstremum człony liniowe znikają
$$E_{n}(\vec{k}) = E_{n}(0) + \sum_{i=1}^{3} \sum_{j=1}^{3} \left(\frac{1}{m^{*}}\right) \frac{\hbar^{2}k_{i}k_{j}}{2} + \cdots$$

$$E_n(\vec{k}) = E_n(0) + \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 \left(\frac{1}{m_{ij}^*}\right) \frac{\hbar^2 k_i k_j}{2} + \cdots$$

Wprowadzamty tzw. tensor odwrotności masy efektywnej:

$$\frac{1}{m_{ij}^*} = \frac{\delta_{ij}}{m} + \frac{2\hbar^2}{m^2} \sum_{l \neq n} \frac{\int u_{n,0} \frac{\partial}{\partial x_i} u_{l,0} d^3 r \cdot \int u_{n,0} \frac{\partial}{\partial x_j} u_{l,0} d^3 r}{E_n(0) - E_l(0)}$$

Tensor jest symetryczny ($m_{ij} = m_{ji}$). Jeśli ekstremum energii jest w punkcie $\Gamma(k=0)$ to powierzchnia stałej energii jest elipsoidą w przestrzeni \vec{k} , która po sprowadzeniu do osi głównych ma postać:

$$E_n(\vec{k}) \approx E_n(0) + \frac{\hbar^2}{2} \left(\frac{k_1^2}{m_1^*} + \frac{k_2^2}{m_2^*} + \frac{k_3^2}{m_3^*} \right)$$

Gdzie m_i^* to masy efektywne w kierunku osi głównych.

Energia $E_n(\mathbf{k})$ wokół ekstremum dla kryształu jednoosiowego (np. GaN):

$$E_n(\vec{k}) = E_n(0) + \frac{\hbar^2}{2} \left(\frac{k_1^2 + k_2^2}{m_{\perp}^*} + \frac{k_3^2}{m_{\parallel}^*} \right)$$

Dla kryształu kubicznego:

$$E_n(\vec{k}) = E_n(0) + \frac{\hbar^2 k^2}{2m^*}$$
 tzw. pasmo **sferyczne**

W pobliżu ekstremum (np. punkt $\Gamma(k=0)$) możemy ograniczyć się do przybliżenia parabolicznego – **pasmo parabloczne**.

W ogólności w zależności energii od wektora falowego występują człony wyższego rzędu, które zostały zaniedbane (wyższe rzędy rachunku zaburzeń).

W ogólności energia elektronu jest funkcją składowych wektora falowego $k = (k_1, k_2, k_3)$. Powierzchnia stałej energii w ogólnym przypadku może mieć skomplikowany charakter, a jej kształt zależy od wszystkich pasm.

Badanie tensora masy efektywnej to jeden z głównych problemów fizyki ciała stałego.

Energia $E_n(\mathbf{k})$ wokół ekstremum



Struktura pasmowa ciał stałych

Przykłady:



Struktura pasmowa ciał stałych



The energy $E_n(\mathbf{k})$ around extremum for the uniaxial crystal (np. GaN):

$$E_n(\vec{k}) = E_n(0) + \frac{\hbar^2}{2} \left(\frac{k_1^2 + k_2^2}{m_{\perp}^*} + \frac{k_3^2}{m_{\parallel}^*} \right)$$

For a cubic crystal:



Elektrony i dziury





FIGURE 2.17. Valence bands constructed from p orbitals. (a) Lattice of p_z orbitals. (b) Band structure of the p_z orbitals only; the band is 'light' along k_z to the right and 'heavy' along k_x (or k_y) to the left. (c) Total bands from all three p orbitals, showing a doubly degenerate 'heavy' band and a single 'light' band.

Elektrony i dziury

$$f_d = \sum_{\substack{i=1\\i\neq j}}^{2N} f(\mathbf{k}_i) \qquad \mathbf{k}_d = \sum_{\substack{i=1\\i\neq j}}^{2N} \mathbf{k}_i = \sum_{\substack{i=1\\i\neq j}}^{2N} \mathbf{k}_i - \mathbf{k}_e = -\mathbf{k}_e$$

 $E_n(\vec{k}) = E_n(0) \pm \frac{\hbar^2 k^2}{2m^*}$

 $\mathbf{v}_d(\mathbf{k}_e) = -\mathbf{v}_e(\mathbf{k}_e)$ $\mathbf{v}_d(\mathbf{k}_d) = \mathbf{v}_e(\mathbf{k}_e)$



Potencjał kulombowski (ekscyton)

NAJPIERW:

Potencjał kulombowski 3D w półprzewodniku o stałej dielektrycznej ε_r , masie efektywnej m^* :

 $V(r) = -\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_r\varepsilon_0}\frac{1}{r}$ $Ry = \left(\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0}\right)^2 \frac{m}{2\hbar^2} = \frac{\hbar^2}{2ma_B^2} = \frac{1}{2}\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0a_B} = 13.6 \text{ eV}$ $a_B = \frac{4\pi\varepsilon_0\hbar^2}{m_0e^2} = 0.5 \text{ Å}$ $E_n = -Ry\frac{1}{n^2}$ $E_n = -\left(\frac{m^*}{n}\right)\frac{1}{2}Ry\frac{1}{n^2}$

$$E_n = -\left(\frac{m^*}{m_0}\right) \frac{1}{\varepsilon_r^2} Ry \frac{1}{n^2}$$
$$a_B^* = \frac{4\pi\varepsilon_r\varepsilon_0\hbar^2}{m_0e^2} \left(\frac{m_0}{m^*}\right) = a_B\varepsilon_r \left(\frac{m_0}{m^*}\right)$$

Potencjał periodyczny

W przypadku funkcji Blocha
$$\varphi_{\vec{k}}(\vec{r}) = u_{\vec{k}}(\vec{r})e^{i\vec{k}\vec{r}}$$
:
 $\varphi_{\vec{k}}(\vec{r}+N_j\vec{a}_j) = u_{\vec{k}}(\vec{r}+N_j\vec{a}_j)e^{i\vec{k}(\vec{r}+N_j\vec{a}_j)}$
 $= u_{\vec{k}}(\vec{r})e^{i\vec{k}\vec{r}}e^{i\vec{k}N_j\vec{a}_j}$

Musimy zażądać, żeby $e^{i\vec{k}N_j\vec{a}_j} = 1$

$$\vec{k}_j = 0, \pm \frac{2\pi}{L_j}, \pm \frac{4\pi}{L_j}, \dots, \pm \frac{2\pi N_j}{L_j}$$



dozwolone wektory falowe stanowią dyskretną sieć punktów równomiernie rozłożoną w przestrzeni wektora falowego; komórkę elementarną sieci odwrotnej (strefę Brillouina) wypełnia

$$N_1 \cdot N_2 \cdot N_3$$

takich punktów. Tyle też będzie stanów w każdym paśmie. N_1 , N_2 , N_3 mogą być różne, ale najczęściej przyjmujemy takie same

M. Baj Fizyka materii skondensowanej i struktur półprzewodnikowych

Gęstość stanów Ilość stanów na jednostkę energii $\rho^{nD}(E)$ (zależy od ilości wymiarów)

Jeśli nasz kryształ ma skończone rozmiary zbiór wektorów k jest skończony (choć olbrzymi!), np. możemy przyjąć periodyczne warunki brzegowe i wtedy:



Gęstość stanów Ilość stanów na jednostkę energii $\rho^{nD}(E)$ (zależy od ilości wymiarów)

Gęstość stanów w przestrzeni k o wymiarach n (w jednostkowej objętości) $\rho_k^{nD} = 2\left(\frac{1}{2\pi}\right)'$

Przypadek 3D

$$\rho^{3D}(E)dE = \rho_k^{3D}d\vec{k} = 2\left(\frac{1}{2\pi}\right)^3 4\pi k^2 dk$$

Dla pasma sferycznego i parabolicznego:

$$\rho_c^{3D}(E) = \frac{1}{2\pi^2} \left(\frac{2m_0 m_c^*}{\hbar^2}\right)^{3/2} \sqrt{E - E_c}$$

$$\rho_{v}^{3D}(E) = \frac{1}{2\pi^{2}} \left(\frac{2m_{0}m_{h}^{*}}{\hbar^{2}}\right)^{3/2} \sqrt{E_{v} - E}$$



Gęstość stanów Ilość stanów na jednostkę energii $\rho^{nD}(E)$ (zależy od ilości wymiarów)

Gęstość stanów w przestrzeni k o wymiarach n (w jednostkowej objętości) $\rho_k^{nD} = 2\left(\frac{1}{2\pi}\right)^k$

Przypadek 3D

$$\rho^{3D}(E)dE = \rho_k^{3D}d\vec{k} = 2\left(\frac{1}{2\pi}\right)^3 4\pi k^2 dk$$

Przypadek 2D

$$\rho^{2D}(E)dE = \rho_k^{2D}d\vec{k} = 2\left(\frac{1}{2\pi}\right)^2 2\pi k \, dk$$

Przypadek 1D

$$\rho^{1D}(E)dE = \rho_k^{1D}d\vec{k} = 2\left(\frac{1}{2\pi}\right)^1 2 dk$$



Gęstość stanów Ilość stanów na jednostkę energii $\rho^{nD}(E)$ (zależy od ilości wymiarów)

Gęstość stanów w przestrzeni k o wymiarach n (w jednostkowej objętości) $\rho_k^{nD} = 2\left(\frac{1}{2\pi}\right)'$

Przypadek 3D

$$\rho^{3D}(E)dE = \rho_k^{3D}d\vec{k} = 2\left(\frac{1}{2\pi}\right)^3 4\pi k^2 dk$$

Dla pasma sferycznego i parabolicznego:

$$\rho_c^{3D}(E) = \frac{1}{2\pi^2} \left(\frac{2m_0 m_c^*}{\hbar^2}\right)^{3/2} \sqrt{E - E_c}$$

$$\rho_{v}^{3D}(E) = \frac{1}{2\pi^{2}} \left(\frac{2m_{0}m_{h}^{*}}{\hbar^{2}}\right)^{3/2} \sqrt{E_{v} - E}$$



Gęstość stanów Ilość stanów na jednostkę energii $\rho^{nD}(E)$ (zależy od ilości wymiarów)

Gęstość stanów w przestrzeni k o wymiarach n (w jednostkowej objętości) $\rho_k^{nD} = 2\left(\frac{1}{2\pi}\right)^{r}$



Wewnątrz studni:



If a crystal with a primitive cubic lattice contains N atoms and thus N primitive unit cells, then an **atomic energy level** E_i of the free atom will split into N states (due to the interaction with the rest of N - 1 atoms). **Each band can be occupied by** 2N **electrons**.



H. Ibach, H. Lüth, Solid-State Physics

An odd number of electrons per cell (metal)

An even number of electrons per cell (non-metal) An even number of electrons per cell but overlapping bands (metals of the II group, e.g. Be → next slide!)

The existence of the band structure arising from the discrete energy levels of isolated atoms due to the interaction between them. We can classify the electronic states as belonging to the electronic shells s, p, d etc.



The existence of a forbidden gap is not tied to the periodicity of the lattice! Amorphous materials can also display a band gap.

If a crystal with a primitive cubic lattice contains N atoms and thus N primitive unit cells, then an **atomic energy level** E_i of the free atom will split into N states (due to the interaction with the rest of N - 1 atoms).

Each band can be occupied by 2N electrons.

Fig. 1.1. Broadening of the energy levels as a large number of identical atoms from the first row of the periodic table approach one another (schematic). The separation r_0 corresponds to the approximate equilibrium separation of chemically bound atoms. Due to the overlap of the 2s and 2p bands, elements such as Be with two outer electrons also become metallic. Deep-lying atomic levels are only slightly broadened and thus, to a large extent, they retain their atomic character

The states can mix: for instance sp^3 hybridization.





Fig. 7.9. Schematic behavior of the energy bands as a function of atomic separation for the tetrahedrally bound semiconductors diamond (C), Si, and Ge. At the equilibrium separation r_0 there is a forbidden energy gap of width E_g between the occupied and unoccupied bands that result from the sp^3 hybrid orbitals. For diamond, the sp^3 hybrid stems from the 2s and $2p^3$ atomic states, for Si from the 3s and $3p^3$, and for Ge from the 4s and $4p^3$. One sees from this figure that the existence of a forbidden energy region is not tied to the periodicity of the lattice. Thus amorphous materials can also display a band gap. (After [7.1])

Fig. 1.1. Broadening of the energy levels as a large number of identical atoms from the first row of the periodic table approach one another (schematic). The separation r_0 corresponds to the approximate equilibrium separation of chemically bound atoms. Due to the overlap of the 2s and 2p bands, elements such as Be with two outer electrons also become metallic. Deep-lying atomic levels are only slightly broadened and thus, to a large extent, they retain their atomic character



FIG. 2. Density of states of Al. The states responsible for structure are indicated by letters denoting their irreducible representations. The arrows at 1.4, 2.4, 5.5, and 13 eV indicate the location of structure in the experimental K absorption in Ref. 6.

The band theory of solids.



Fig. 11.4. Room-temperature bandgap energy versus lattice constant of common elemental and binary compound semiconductors.

Teoria pasmowa ciał stałych.



67

Teoria pasmowa ciał stałych.



półprzewodnik typu p

półprzewodnik typu n

Domieszki i defekty

Model wodoropodobny

Atom o wartościowości wyższej o jeden niż atom macierzysty staje się źródłem potencjału kulombowskigo zmodyfikowanego stałą dielektryczną kryształu, wywołanego dodatkowym protonem w jądrze. Dodatkowy elektron będący w paśmie przewodnictwa odczuwa ten potencjał. Jego stany są opisane równaniem masy efektywnej:

$$T = -\frac{\hbar^2}{2m^*}\Delta \qquad U = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{e^2}{\varepsilon_r r}$$

 $[T+U]\phi(\vec{r}) = E\phi(\vec{r})$

II	Ш	IV	V	VI
Be	В	С	N	0
Mg	AI	Si	Ρ	S
Zn	Ga	Ge	As	Se
Cd	In	Sn	Sb	Те

Grupa IV: diament, Si, Ge Grupy III-V: GaAs, AlAs, InSb, InAs... Grupy II-VI: ZnSe, CdTe, ZnO, SdS...

Domieszki i defekty

Model wodoropodobny

Ostatecznie zagadnienie sprowadza się do problemu atomu wodoru z nośnikiem swobodnym o masie m*, w ośrodku dielektrycznym ze stałą ɛ i małą "poprawką" do potencjału.

$$E_n = -\left(\frac{m^*}{m_0}\right) \frac{1}{\varepsilon_r^2} Ry \frac{1}{n^2}$$

$$a_B^* = \frac{4\pi\varepsilon_r\varepsilon_0\hbar^2}{m_0e^2} \left(\frac{m_0}{m^*}\right) = a_B\varepsilon_r\left(\frac{m_0}{m^*}\right)$$

Dla typowych półprzewodników $m_e^* \approx 0.1 m_e$ $\varepsilon_s \approx 10$:

Dla wodoru Ry = 13.6 eV oraz $a_B = 0.053$ nm

Dla GaAs $Ry^* \approx 5$ meV oraz $a_B^* \approx 10$ nm

Π	III	IV	V	VI
Be	В	С	N	0
Mg	AI	Si	Ρ	S
Zn	Ga	Ge	As	Se
Cd	In	Sn	Sb	Те

Grupa IV: diament, Si, Ge Grupy III-V: GaAs, AlAs, InSb, InAs... Grupy II-VI: ZnSe, CdTe, ZnO, SdS...

Spektroskopia w dalekiej podczerwieni



Domieszki i defekty

Model wodoropodobny

jonizacja domieszki



Teoria pasmowa ciał stałych.

Dioda – czyli złącze p-n





Teoria pasmowa ciał stałych.

Dioda – czyli złącze p-n



Flat band
Teoria pasmowa ciał stałych.

Dioda – czyli złącze p-n



Domieszkowanie półprzewodników



Figure 9.3: The energy diagram for the transition region of a p-n junction.



dla półprzewodników skompensowanych w niskich temperaturach energia aktywacji termicznej wynosi E_D , a nie $\frac{E_D}{2}$

jeśli domieszek jest dużo, tak, że funkcje falowe związanych na nich elektronów się przekrywają – energie jonizacji maleją, tworzą się pasma domieszkowe

przy koncentracjach domieszek rzędu:

$$a_B^* \cdot (N_D)^{\frac{1}{3}} \approx 0.26$$

zachodzi przejście fazowe niemetal-metal (tzw. przejście Motta)





Równanie neutralności – niska temperatura, obszar jonizacji termicznej domieszek



Niska temperatura, obszar jonizacji termicznej domieszek

Rozważmy półprzewodnik, w którym:

- $N_A \approx 0 \text{koncentracja akceptorów}$
- N_D koncentracja donorów
- N_A^0 koncentracja neutralnych akceptorów
- N_D^0 koncentracja neutralnych donorów
- *n* koncentracja elektronów w paśmie przewodnictwa

 $p \approx 0 - \text{koncentracja dziur w paśmie}$ walencyjnym

Z warunku neutralności kryształu:

$$n = N_D - N_D^0$$

ENERGIA ELEKTRONÓW

Równanie neutralności



ENERGIA ELEKTRONÓW

